D10XB□

800V 10A

特 長

- 薄型 SIP パッケージ
- UL E142422
- 大電流容量
- 高耐圧・高 I_{FSM}
- 高放熱伝導性

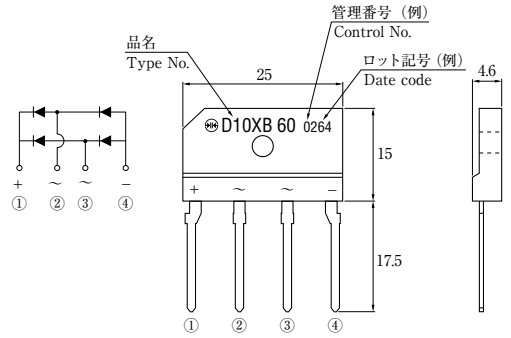
Feature

- Thin-SIP
- UL E142422
- Large Io
- High Voltage・Large I_{FSM}
- High Thermal Radiation

■外観図　OUTLINE

Package：3S

Unit : mm
Weight : 4.4g(typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表　RATINGS

●絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tc=25℃／unless otherwise specified）

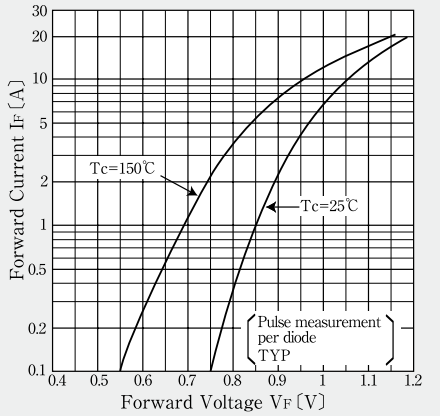
項　目 Item	記号 Symbol	条　件 Conditions		品　名 Type No. D10XB20	D10XB60	D10XB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			−40～150			℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150			℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波，抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink Tc=100℃	10			A
			フィンなし Without heatsink Ta=25℃	2.7			
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波，非繰り返し 1 サイクルせん頭値，Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃		120			A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	1ms≦t<10ms，Tj=25℃，1 素子当たりの規格値 per diode		60			A^2s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間，AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5			kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	（推奨値：0.5 N・m） (Recommended torque : 0.5 N・m)		0.8			N・m

●電気的・熱的特性　Electrical Characteristics（指定のない場合 Tc=25℃／unless otherwise specified）

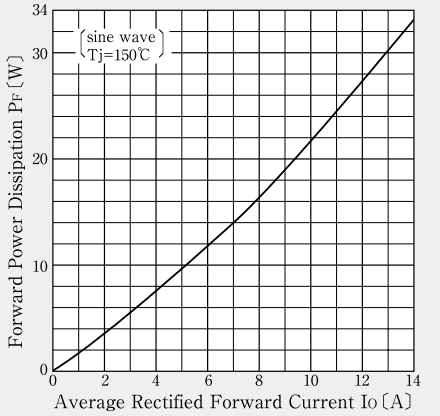
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F=5A, パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R=V_{RM}, パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間，フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 2.3	℃/W
	θjl	接合部・リード間，フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θja	接合部・周囲間，フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 26	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

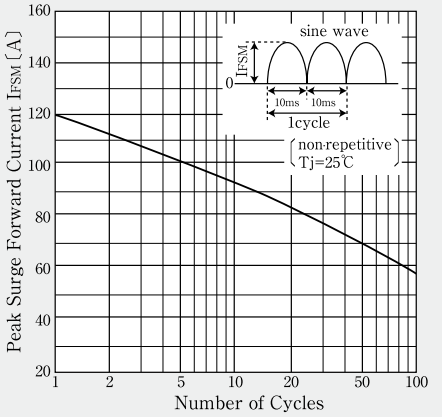
順方向特性
Forward Voltage



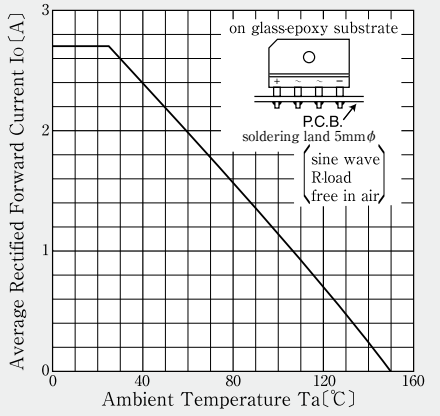
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



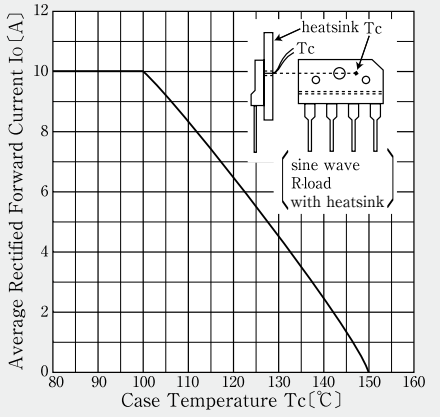
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



＊ Sine wave は 50Hz で測定しています。
＊ 50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
＊ Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9